



ВТОРОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

**Министерство Образования и Науки Российской Федерации
Российская Академия Наук**

**Московский Государственный Университет
им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Физико-Технический Институт им. А.Ф.Иоффе РАН
Институт СВЧ Полупроводниковой Электроники РАН**

**при финансовой поддержке
Российского Фонда Фундаментальных Исследований**

и спонсоров:

"Светлана - Оптоэлектроника",

"СемиТех"

"AIXTRON"

"VEECO"

"LAY TEC –GESELLSCHAFT"

"TDI"

**5-я Всероссийская Конференция
«Нитриды галлия, индия и алюминия:
структуры и приборы»**

Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова

Москва, 31 января - 02 февраля 2007 г.

СРОКИ И ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ:

31 января - 02 февраля 2007 года в Москве, на физическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова будет проведена **5-я Всероссийская Конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы».**

Опираясь на опыт предыдущих Совещаний и Конференций, а так же учитывая расширение круга участников, оргкомитет решил провести Конференцию в течение трех дней. Формат – устный и стендовый. Устные сессии будет предваряться приглашенными докладами. Официальный язык Конференции – Русский. Часть докладов (от зарубежных участников) может быть сделана на Английском языке. Размер стендового доклада А0. На Конференции будет организована выставка промышленных компаний.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1. Эпитаксия III-N материалов.
2. Объемный рост III-N материалов.
3. Опыт создания, запуска и эксплуатации оборудования для эпитаксии нитридов III группы в России
4. Нестандартные III-N структуры и родственные материалы
5. Оптические, электрические и структурные свойства III-N структур.
6. Приборы на основе III-нитридов.
7. Светодиоды и лазеры на основе нитридов.
8. Светодиоды и системы освещения.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Развернутые тезисы докладов на Русском языке (на 2 стр. по прилагаемой форме) и краткие тезисы на Английском языке (100 слов по прилагаемой форме), направленные до 1 Декабря 2006 года по электронной почте (Nitrides2007@mail.ioffe.ru) будут опубликованы до начала конференции.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ:

Оргкомитет выражает глубокую благодарность Российскому Фонду Фундаментальных Исследований и спонсорам: "Светлана - Оптоэлектроника", "СемиТех", "AIXTRON", "VEECO", "LAY TEC –GESELLSCHAFT", "TDI" за финансовую поддержку Конференции.

Благодаря этой поддержке организационный взнос от участников Конференции мог быть уменьшен до 500 руб. Аспиранты и студенты – участники Конференции - будут освобождены от организационного взноса. В особых случаях будет возможна оплата дорожных расходов.

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА

В соответствии с новыми бухгалтерскими и налоговыми правилами организационный взнос должен быть внесен через Банк на расчетный счет Физического факультета МГУ. Это может быть сделано заранее через Сбербанк или, при регистрации на самой Конференции, через МИБАНК, в помещении факультета.

Форма приходной квитанции для оплаты взноса с указанием реквизитов факультета прилагается.

Сумма взноса – 500 руб. – покрывает часть расходов на издание Программы и тезисов, на почтовые и канцелярские цели, на обеспечение перерывов.

Форма приходной квитанции для оплаты взноса и реквизиты факультета.

ПОЛУЧАТЕЛЬ : КБК 38630302010010000180 П.6 РАЗР.386/008 Орг. взнос на проведение 5-й Всероссийской конференции «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы» Ф.И.О участника
ИНН /КПП 7729182048 /772901001 отделение по ЗАО
Л/С УФК ПО г.Москве Физический факультет МГУ им М.В.Ломоносова
0638643190

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Отделение 1 Московского ГТУ банка России г.Москва 705
Расчетный счет: 40503810600001009008
БИК: 044583001

РЕГИСТРАЦИЯ

Оргкомитет благодарит участников Конференции, заранее приславших Форму Предварительной Регистрации в электронном виде. **Список зарегистрированных участников Конференции прилагается.**

Регистрация и прием организационных взносов будут проводиться в первый день Конференции на физическом факультете МГУ, на 1-м этаже, направо после входа на факультет, в комнате 1-31.

Просьба к участникам, еще не приславшим форму предварительной регистрации, заполнить прилагаемую форму заранее, чтобы сократить время регистрации в начале Конференции. **Форма прилагается.**

Форма предварительной регистрации

(ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ПРЕДПОЛАГАЕМОГО УЧАСТНИКА)

1. Фамилия, Имя, Отчество.
2. Организация.
3. Должность.
4. Ученая степень, ученое звание.
5. Количество предполагаемых докладов (представляемых лично Вами).
6. Темы докладов, представляемых данным участником (в соответствии с нумерацией, приведенной в программе Конференции).
7. Необходимость финансовой поддержки.
8. Необходимость резервирования места в гостинице.
9. Телефон, E-mail.

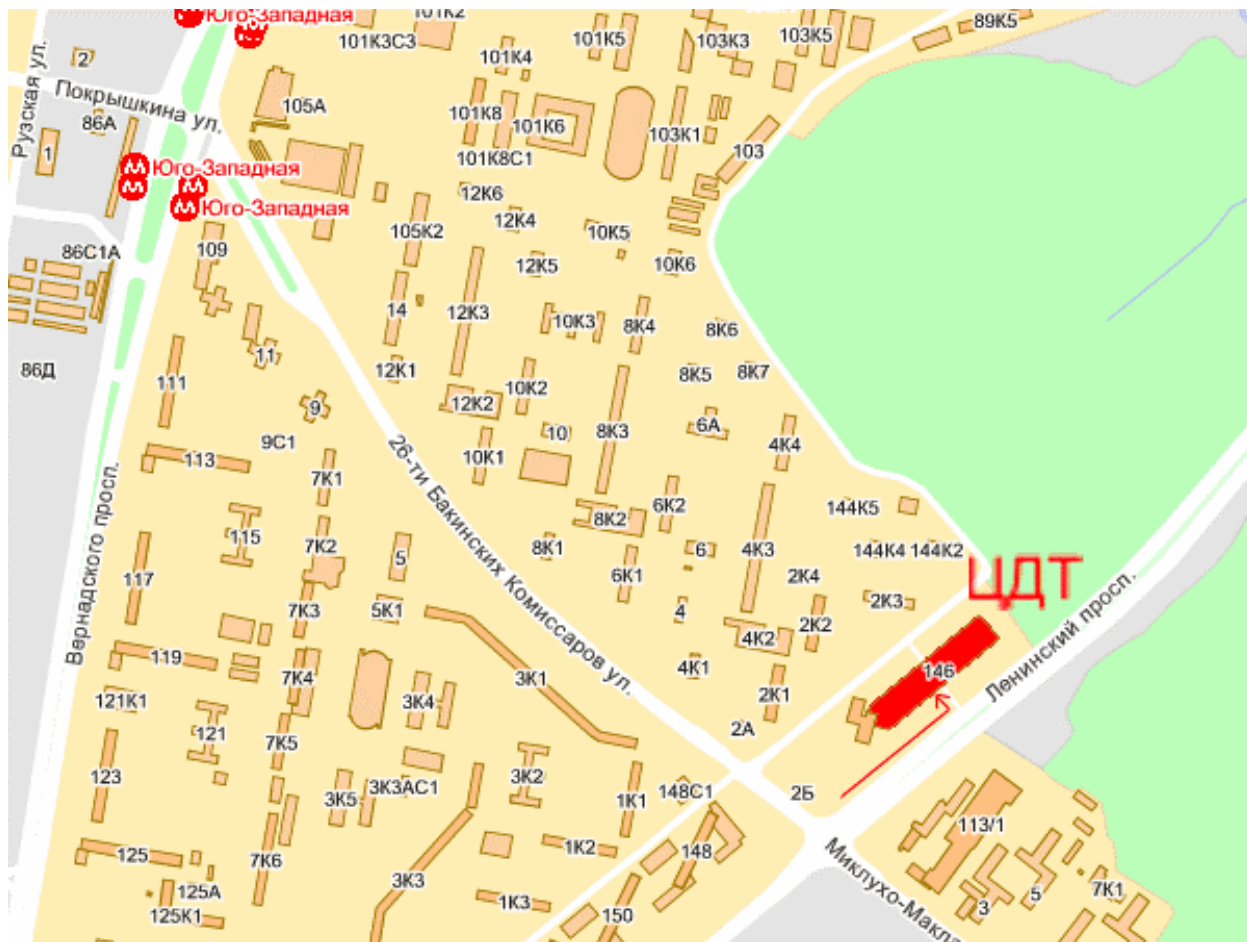
Желательно отправить заполненную форму до начала конференции по адресу andrey_turkin@yahoo.com.

ГОСТИНИЦА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА»

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, дом 146, на углу с улицей 26 Бакинских Комиссаров. В ней забронированы места для участников Конференции, заранее предупредивших о необходимости гостиницы. Ближайшая станция метро – «Юго-Западная»; от гостиницы до метро (две остановки) идут троллейбусы 62, 84 и несколько автобусов. Утром перед заседаниями к гостинице будет подаваться автобус для

участников Конференции. **Карта расположения гостиницы относительно метро прилагается.**

В первый день Конференции в фойе гостиницы будет находиться представитель Оргкомитета для помощи в устройстве участников. Стоимость одноместного номера – 1945 руб. в сутки, двухместного - 2270 руб. В стоимость проживания включены завтрак и медицинская страховка.



Институт СВЧ полупроводниковой электроники РАН

Адрес Института: Нагорный проезд, д. 7, кор.8.0;

Проезд городским транспортом: от факультета - авт. 130, 67, тролл. 49 до м. "Профсоюзная", пересечь на авт. 44, остановка «Страховое Общество «РЕСО-Гарантия»»; или от центра до м. "Тульская", пересечь на авт.25, остановка «Институт Вакуумной Техники»/ «Страховое Общество «РЕСО-Гарантия»».

Для входа надо иметь паспорт.

Во второй день Конференции после обеда будет подан автобус от физического факультета МГУ до Института СВЧ ПЭ РАН.

С информацией о конференции можно ознакомиться на сайте факультета

www.phys.msu.ru или на сайте конференции:

<http://www.phys.msu.ru/rus/research/conferences/2006-nitrides/nitrides.htm> .

ОРКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

П.К.Кашкаров	МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель
А.Э.Юнович	МГУ им. М.В.Ломоносова, зам. председателя
П.С.Копьев	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, зам. Председателя
А.Н.Туркин	МГУ им. М.В.Ломоносова, ученый секретарь
В.В.Лундин	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, ученый секретарь
А.А.Арендаренко	ЗАО "Элма-Малахит"
В.Н.Данилин	ГУП "Пульсар"
П.В.Иванников	МГУ им. М.В.Ломоносова
А.Ф.Иванов	РФЯЦ – ВНИИТФ, МинАтом, Снежинск
А.Ю.Игнатов	ЗАО «Монокристалл»
Г.В.Иткинсон	“Светлана - Оптоэлектроника”
А.Н.Ковалев	МИСиС
В.Г.Мокеров	ИСВЧПЭ РАН
А.Е.Николаев	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН
М.А.Ормонт	МГУ им. М.В.Ломоносова
В.Г.Сидоров	СПбГТУ
П.А.Форш	МГУ им. М.В.Ломоносова
В.П. Чалый	«СемиТех»
М.В.Чукичев	МГУ им. М.В.Ломоносова

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

А.Э.Юнович	МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель
П.С.Копьев	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, зам. Председателя
А.В.Сахаров	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, секретарь
Л.М.Коган	НПЦ «Оптэл»
В.В.Лундин	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН
Ю.Н.Макаров	ЗАО «Нитридные кристаллы»
Ф.И.Маняхин	МИСИС
М.Г.Мильвидский	ГИРЕДМЕТ
О.П.Пчеляков	ИФП СО РАН
В.Г.Сидоров	СПбГТУ
С.Ю.Шаповал	ИПТМ РАН

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

СРЕДА, 31 января
РЕГИСТРАЦИЯ – 9.00. – 12.30.,
Физический факультет МГУ, ауд. 1-31.

АВТОБУСЫ ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО МГУ. 10.00.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, 11.30 – 14.25
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ,
АУДИТОРИЯ им. Р.В.ХОХЛОВА

Открытие. 11.30. - 12.00.

11.30 - 11.40. ПРИВЕТСТВИЕ ОТ МГУ - Председатель - проф. П.К.КАШКАРОВ

11.40-11.45. О РЕГЛАМЕНТЕ. Ученый секретарь Оргкомитета *А.Н.Туркин.*

11.45 - 12.00. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ НИТРИДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
В РОССИИ И В МИРЕ, Председатель Программного Комитета *А.Э.Юнович*

12.00 – 14.30. ЭПИТАКСИЯ III-N МАТЕРИАЛОВ

Председатель – П.С.Копьев.

12.00 – 12.15. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ III-N СТРУКТУР
НА SiC ПОДЛОЖКАХ ДЛЯ СИНИХ СВЕТОДИОДОВ МЕТОДОМ МОСVD

В.В.Лундин, А.Е.Николаев, Е.Е.Заварин, М.А.Синицын, А.В.Сахаров, С.О.Усов, А.Ф.Цацульников

12.15 – 12.30. ВЛИЯНИЕ ПАРАЗИТНЫХ РЕАКЦИЙ НА МОС–ГИДРИДНОЕ ОСАЖДЕНИЕ AlGaIn

А.В. Лобанова, Е.В. Яковлев, Р.А. Талалаев

12.30 – 12.45. НЕПОЛЯРНЫЕ a-(In)GaIn ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ

*Е.Е.Заварин, В.В.Лундин, М.А.Синицын, А.Е.Николаев, А.В.Сахаров, Д.С.Сизов, М.М.Кулагина,
А.Ф.Цацульников*

12.45 – 13.00. ЭПИТАКСИАЛЬНЫЕ СЛОИ GaIn НА Si(111) ПОДЛОЖКЕ: СТРУКТУРНЫЕ И
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

*В.Н.Бессолов, В.Ю.Давыдов, Ю.В.Жиляев, Е.В.Коненкова, Н.К.Полемаев, С.Д.Раевский,
С.Н. Родин, С.Л.Смирнов, Ш.Шарофидинов, М.П.Щеглов, H.S. Park и M. Koike*

13.00 – 13.15. ПЕРЕРЫВ

ЭПИТАКСИЯ III-N МАТЕРИАЛОВ

Председатель – М.Г.Мильвидский.

13.15 – 13.35. CVD TECHNOLOGY AND PRODUCTION FOR SOLID STATE LIGHTING

F. Schulte, B. Schineller, M. Heuken

13.35 – 13.55 ROLE OF COMPUTATION FLUID DYNAMIC IN THE NEW MOCVD EQUIPMENT AND
PROCESS DEVELOPMENT FOR GaIn MATERIALS

B. Mitrovic, A. Gurary, B. Quinn, E. Armour

13.55 – 14.10. TEMPERARURE MEASUREMENT AND CONTROL DURING DEPOSITION OF THE GaIn
RELARED MATERIALS

M. Belousov, B. Mitrovic, S. Ting, A. Gurary, B. Quinn

14.10-14.30. ON THE PHYSICS OF OPTICAL IN-SITU MONITORING OF MOVPE GROWTH PROCESSES
FOR STATE-OF-THE-ART III-NITRIDE DEVICES

E. Steimetz, F. Brunner, T. Schenk, T. Trepk, and J.-T. Zettler

14.30 – 15.30. ОБЕД

**ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, 15.30 – 19.15.
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ, АУДИТОРИЯ им. Р.В.ХОХЛОВА**

**15.30 – 16.30. ЭПИТАКСИЯ И ОБЪЕМНЫЙ РОСТ III-N МАТЕРИАЛОВ
Председатель – А.А.Арендаренко.**

15.30 – 15.45. ВЫРАЩИВАНИЕ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ GaN ХЛОРИД-ГИДРИДНЫМ МЕТОДОМ
А.В. Говорков, Л.И. Дьяконов, Ю.П. Козлова, А.В. Марков, М.В. Меженный, А.Я. Поляков, В.Ф. Павлов, Н.Б. Смирнов, Т.Г. Югова

15.45 – 16.00. ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ РОСТА СОЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ AlN-GaN АММИАЧНОЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВОЙ ЭПИТАКСИЕЙ
А.Н. Алексеев, А.Э. Бырназ, Д.М. Красовицкий, М.В. Павленко, С.И. Петров, И.А. Соколов, М.А. Соколов, А.П. Шкурко, В.П. Чалый

16.00 – 16.15 InGaN QW С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ДИАПАЗОНЕ 490-630 нм, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ МПЭ НА с-Al₂O₃
С.В. Иванов, В.Н. Жмерик, Т.В. Шубина, С.В. Листошин, А.М. Мизеров, А.А. Ситникова, П.С. Копьев

16.15 – 16.30. МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВАЯ ЭПИТАКСИЯ С ПЛАЗМЕННОЙ АКТИВАЦИЕЙ AlGaN-ГЕТЕРОСТРУКТУР ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНА
Жмерик В.Н., Семенов А.В., Мизеров А.М., Шубина Т.В., Торопов А.А., Листошин В.Б., Сахаров А.В., Заморянская М.В., Копьев П.С., Иванов С.В.

16.30 – 16.45. ПЕРЕРЫВ

**16.30 – 19.15. СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ И ВЫСТАВКА
ФОЙЕ АУДИТОРИИ ИМ. Р.В.ХОХЛОВА**

**17.00 – 19.15. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ:
ОПЫТ СОЗДАНИЯ, ЗАПУСКА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ЭПИТАКСИИ НИТРИДОВ III ГРУППЫ В РОССИИ
Председатель – О.П.Пчеляков.**

ОТ ЗАДАЧ НИТРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К ВОЗМОЖНОСТЯМ ОБОРУДОВАНИЯ
А.Н. Алексеев, Л.А. Великовский, Ю.В. Погорельский, А.Г. Филаретов, В.П. Чалый

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЛЭ-СИСТЕМ ПРИ РОСТЕ ПЛЕНОК GaN В ПОТОКЕ АММИАКА
В.В. Преображенский, М.А. Путьято, Б.Р. Семягин, А.В. Васев, В.Г. Мансуров, К.С. Журавлев, А.И. Торопов, О.П. Пчеляков

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВКИ D-180 (VEECO) ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ InGaN/GaN СТРУКТУР ДЛЯ СИД
Ю.Н. Свешников, Р.В. Харламов, И.Н. Цыпленков

СОЗДАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ III-N СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ МОГФЭ
Е.Е. Заварин, В.В. Лундин, М.А. Синицын, А.Ф. Цацульников

АНАЛИЗ ОПЫТА ЗАПУСКА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ МОУРЕ УСТНОВКИ AlX2000HT В ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
В.В. Лундин, Е.Е. Заварин, М.А. Синицын, А.Е. Николаев, А.Ф. Цацульников

ОБСУЖДЕНИЕ, КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

19.15. – 20.50. – ФУРШЕТ

АВТОБУСЫ ОТ МГУ ДО ГОСТИНИЦЫ. 21.00.

ЧЕТВЕРГ, 01 февраля
АВТОБУСЫ ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО МГУ 9.15.
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, 10.00 – 14.00
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ, АУДИТОРИЯ им. Р.В.ХОХЛОВА

**10.00 – 11.30 НЕСТАНДАРТНЫЕ Ш-N СТРУКТУРЫ
И РОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**
Председатель – В.Г.Сидоров.

10.00 – 10.10. СЛАЙД-ШОУ «НИТРИДНАЯ НАНОСКУЛЬПТУРА» / РЕГЛАМЕНТ

10.10 – 10.30 ГИБРИДНЫЕ II-O/III-N СВЕТОДИОДЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАБОТЫ

К. А. Булашевич, И. Ю. Евстратов, С. Ю. Карпов

10.30 – 10.45 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РОСТА МОНОКРИСТАЛЛОВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ КАРБИДА КРЕМНИЯ С НИТРИДОМ АЛЮМИНИЯ МЕТОДОМ СУБЛИМАЦИИ

Б.А. Биалов, Г.Д. Кардашова, М.А. Гитикчиев, Я.А. Алимагомедов

10.45 – 11.00 ЭФФЕКТ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИПОВ(β -SiC)-(α -SiC) ПРИ КАРБОНИЗАЦИИ Si(111) ПОДЛОЖКИ

М.Е.Компан, С.А.Кукушкин, А.В.Осипов, И.Г.Аксапов, В.Н.Бессолов, Е.В.Коненкова, С.К.Гордеев, С.Б.Корчагина

11.00 – 11.15 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ПЛЕНОК ZnO

М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Э.Ю. Даниловский, Р.В. Кузьмин

11.15 – 11.30 ВИДИМОЕ И ДЛИННОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В КРИСТАЛЛАХ GaN, ЛЕГИРОВАННЫХ Eu И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕДЕННОЙ ПРИМЕСЬЮ Zn

М.М.Мездрогина, В.В.Криволапчук, В.Н.Петров, Ю.В.Кожанова, Э.Ю.Даниловский, Р.В.Кузьмин

11.30 – 11.45 ПЕРЕРЫВ

11.45 – 13.20 СВОЙСТВА Ш-N ГЕТЕРОСТРУКТУР

Председатель – А.В.Сахаров.

11.45 – 12.05 ОПТИЧЕСКИ НАКАЧИВАЕМЫЕ ЛАЗЕРЫ НА ОСНОВЕ НИТРИДОВ, ВЫРАЩЕННЫЕ НА КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ

Е. В. Луценко

12.05 – 12.20 ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ СТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ НА ОСНОВЕ InGaN/GaN В РАСТРОВОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ В РЕЖИМЕ НАВЕДЕННОГО ТОКА

Е.Б. Якимов, Н.М. Шмидт

12.20 – 12.35 ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ СО СВЕТЛЫМ КОНТРАСТОМ В РЕЖИМЕ НАВЕДЕННОГО ТОКА В СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ СТРУКТУРАХ InGaN/GaN

П.С. Вергелес, Н.М. Шмидт, Е.Б. Якимов

12.35-12.50 OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF AlGaIn/GaN HETEROSTRUCTURES GROWN ON SILICON AND SAPPHIRE SUBSTRATES BY MOVPE

N. V. Rzhetski, A. L. Gurskii, E. V. Lutsenko, V. N. Pavlovskii, G. P. Yablonskii, A. S. Shulenkoy, A. I. Stognii, M. Heuken, B. Schineller, H. Kalisch, R. H. Jansen

12.50 – 13.05 LIGHT-INDUCED DIFFRACTION KINETICS AND PHOTOLUMINESCENCE IN EPITAXIAL GaN GROWN ON SAPPHIRE SUBSTRATES

V. N. Pavlovskii, E. V. Lutsenko, A. V. Danilchuk, G. P. Yablonskii, T. Malinauskas, R. Aleksiejūnas, K. Jarašiūnas, H. Kalisch, R. H. Jansen, B. Schineller, M. Heuken

13.05 – 13.20 ПЕРЕРЫВ

13.20 – 14.00 КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В РАСПИСАНИЕ

14.00. – 15.00. Обед.

АВТОБУСЫ ОТ МГУ ДО ИСВЧПЭ РАН. 14.30.-15.20.

16.00-17.30 ПРИБОРЫ НА ОСНОВЕ III-N

Председатель – В.Г.Мокеров.

16.00 – 16.15 ТРАНЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ III-N / вступительное слово

В.Г.Мокеров

16.15 – 16.30 МАЛОШУМЯЩИЕ AlGaIn/GaN НЕМТ

Аболдуев И.М., Гладышева Н.Б., Дорوفеев А.А., Миннебаев В.М., Чернявский А.А

16.30 – 16.45 МОЩНЫЙ ПОЛЕВОЙ СВЧ ТРАНЗИСТОР НА МНОГОСЛОЙНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ AlN/AlGaIn/GaN/AlGaIn

А.Н. Алексеев, С.Б. Александров, Д.Е.Беляевский, Л.Э.Великовский, В.Е.Земляков, Д.М.Красовицкий, В.А.Красник, С.И.Петров, М.Ю.Погорельский, В.А.Разумная, А.М.Темнов, А.Г. Ткаченко, В.П.Чалый

16.45 – 17.00 ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР AlN/AlGaIn/GaN/AlGaIn С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ ДЛЯ МОЩНЫХ ПОЛЕВЫХ СВЧ- ТРАНЗИСТОРОВ

А.Н. Алексеев, С.Б. Александров, А.Э. Бырназ, Л.Э. Великовский, И.Э. Великовский, Д.М. Красовицкий, М.В. Павленко, С.И. Петров, М.Ю. Погорельский, Ю.В. Погорельский, И.А. Соколов, М.А. Соколов, М.В. Степанов, А.Г. Ткаченко, А.П. Шкурко, В.П. Чалый

17.00 – 17.15 ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ InGaAlN ДЛЯ НЕМТ-ТРАНЗИСТОРОВ

А.В.Сахаров, В.В. Лундин, Е.Е.Заварин, М.А.Синицин, А.Ф.Цацульников

17.15 – 17.30 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРИБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРО- И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ ПЛЁНОК И ПЛАСТИН

А.А. Арендаренко, А.Г. Васильев, В.Н. Данилин, Т.А. Жукова, В.И. Конов, В.Г. Ральченко, А.В. Петров, Ю.В.Колковский, А.Л.Филатов

17.30-17.45 ПЕРЕРЫВ

17.45 – 18.30 ПРИБОРЫ НА ОСНОВЕ III-N

Председатель – А.Н.Ковалев.

17.45 – 18.00 ДЕТЕКТОРЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР AlN/AlGaIn

С.В. Аверин, Н.В. Алкеев

18.00 – 18.15 ПРИМЕСИ И ДЕФЕКТЫ С ГЛУБОКИМИ УРОВНЯМИ В НИТРИДАХ ЭЛЕМЕНТОВ III ГРУППЫ И В ПРИБОРНЫХ СТРУКТУРАХ НА ИХ ОСНОВЕ

А.Я.Поляков, Н.Б. Смирнов, А.В. Говорков, М.Г. Мильвидский

18.30 18.45 РАДИАЦИОННОЕ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В НИТРИДЕ ГАЛЛИЯ: ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОГО СОВЕРШЕНСТВА ИСХОДНЫХ КРИСТАЛЛОВ

А.Я.Поляков, Н.Б.Смирнов, А.В.Говорков, А.В.Марков, Т.Г.Югова, Н.Г.Колин, Д.И.Меркурисов, В.М.Бойко, In-Hwan Lee, S.J.Pearson, В.Т.Бублик, К.Д.Щербачев, М.И.Воронова

18.45 19.00. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СОЗДАНИЯ МОЩНОГО БАЗОВОГО P-НЕМТ ДЛЯ ВЫХОДНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ X-ДИАПАЗОНА.

А.С.Бугаев, В.Г.Мокеров, Е.Н.Енюшкина, Ю.В.Федоров, Г.Б.Галиев, В.М.Миннебаев, В.Г.Латин

19.00 19.15 ТЕХНОЛОГИЯ МАЛОШУМЯЩИХ P-НЕМТ и МИС X- и K-ДИАПАЗОНОВ.

Ю.В.Федоров, В.Г.Мокеров, А.С.Бугаев, Г.Б.Галиев, Ю.А.Матвеев, В.М.Миннебаев, В.Г.Латин, А.А.Баров

19.15. – 20.50. – ФУРШЕТ

АВТОБУСЫ ОТ ИСВЧПЭ РАН ДО ГОСТИНИЦЫ. 21.00.

ПЯТНИЦА, 02 февраля
АВТОБУСЫ ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО МГУ. 9.15.
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, 10.00 – 13.40
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ, АУДИТОРИЯ им. Р.В.ХОХЛОВА

10.00 – 11.15 III-N СВЕТОДИОДЫ

Председатель – Г.В.Иткинсон.

10.00 – 10.15. СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ НИТРИДА ГАЛЛИЯ ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, Е.Е. Заварин, А.В. Сахаров, Д.С. Сизов, М.А. Сеницын

10.15 – 10.30 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВЫСОКОСОСТАВНЫХ InGaN НАНОВКЛЮЧЕНИЙ В МАТРИЦЕ AlGaIn

В.С. Сизов, А. Ф. Цацульников, В. В. Лундин

10.30 – 10.45 ЭЛЕКТРООТРАЖЕНИЕ В p-n- ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ НА ОСНОВЕ InGaN/GaN/AlGaIn

Л.П.Авакяну, М.Л.Бадгутдинов, П.Ю.Боков, А.В.Червяков, С.С.Широков, А.Э.Юнович

10.45 – 11.00 АНАЛИЗ СПЕКТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИНИХ СВЕТОДИОДОВ НА ОСНОВЕ p-n-ГЕТЕРОСТРУКТУР InGaN/AlGaIn/GaN

М.Л.Бадгутдинов, С.С.Широков, А.Э.Юнович, М.Г.Агапов, Д.В.Давыдов, Д.А.Лавринович, Ф.М.Снегов

11.00 – 11.15 ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕТЕРОСТРУКТУР GaAlN-p/GaInN/n-GaN по ВАХ

Е.Н.Вигдорovich, Ю.Н. Свейников

11.15 – 11.30 ПЕРЕРЫВ

11.30 – 13.40 III-N СВЕТОДИОДЫ

Председатель – А.Н.Туркин.

11.30 – 11.50 LIGHTING WITH LEDS: ILLUMINATING INSIGHTS INTO THE SOLID-STATE LIGHTING MARKET

Tim Whitaker

11.50 – 12.10 ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ

Р.И. Столяревская

12.10 – 12.25 ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ СВЕТОДИОДОВ

Л. С. Ловинский

12.25 – 12.40 МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДЫ БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ С СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ ДО 300 лм И СВЕТОВОЙ ОТДАЧЕЙ ДО 70 лм/Вт

Коган Л.М., Гальчина Н.А., Рассохин И.Т., Социн Н.П.

12.40 – 12.55 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФОТОЛЮМИНОФОРОВ ДЛЯ БЕЛЫХ СИД

Н.П. Социн

12.55 – 13.10 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТРОЙНЫЕ ФОСФОРЫ ДЛЯ БЕЛЫХ СВЕТОДИОДОВ

Р.Б. Джаббаров, Н.Н. Мусаева, Б.Г. Тагиев, О.Б. Тагиев

13.10 – 13.25 ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЛЫХ СВЕТОДИОДОВ

А. Феопёнтов, А. Богданов

13.25 – 13.40 ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТРАЖАЮЩИХ КОНТАКТОВ В ФЛИП-ЧИП СВЕТОДИОДАХ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ AlGaInN

И. П. Смирнова, Д. А. Закгейм, М. М. Кулагина, Е. М. Аракчеева

13.40 – 15.00 Обед

**ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, 15.00 – 16.45
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ, АУДИТОРИЯ им. Р.В.ХОХЛОВА**

**15.00 – 16.45 СВЕТОДИОДЫ И СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Председатель – В.В.Лундин**

15.00 – 15.15. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕГРАДАЦИИ СИНИХ СВЕТОДИОДОВ НА ОСНОВЕ InGaN/GaN

С.А.Бельник, Е.Д.Васильева, Д.В.Давыдов, А.Л.Закгейм, Д.А.Лавринович, Ф.М.Снегов, А.Е.Черняков, Н.М.Шмидт

15.15 – 15.30 ДИНАМИКА ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ И БЕЗЫЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ СИНИХ СВЕТОДИОДОВ

А.А.Грешинов, Д.В.Давыдов, А.Л.Закгейм, Д.А.Лавринович, А.П.Карташова, В.В.Ратников, Ф.М.Снегов, О.А.Солтанович, А.Е.Черняков, Н.М.Шмидт, Е.Б.Якимов

15.30 – 15.45 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ InGaN СВЕТОДИОДОВ

О.И. Рабинович, В.П. Сушков, А.В. Шишов

15.45 – 16.00 ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ МОЩНЫХ InGaN/GaN СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ, ИЗМЕРЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ МЕТОДАМИ

А.В. Данильчик, Е.В. Луценко, В.Н. Павловский, Н.В. Ржеуцкий, К.А. Осипов, Г.П. Яблонский

16.00 – 16.15 ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛУБЫХ InGaN/GaN СВЕТОДИОДОВ

Ю.А. Бумай, О.С. Васьков, Д.С. Доманевский

16.15 – 16.30 АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЯХ

Ю.В. Трофимов, С.Ю. Никитин, В.И. Цвирко, В.К. Сивенков, С.И. Лишик, О.Я. Тихоненко

16.30 – 16.45 СВЕТОДИОДНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Трофимов Ю.В., Поседько В.С., Лишик С.И., Цвирко В.И., Паутино А.А.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 16.50.-17.10.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – А.Э.ЮНОВИЧ

ИНФОРМАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА - А.Н.ТУРКИН, В.В.ЛУНДИН 16.50. - 17.00.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО - П.С.КОПЬЕВ 17.00. - 17.10.

АВТОБУСЫ ОТ МГУ ДО ГОСТИНИЦЫ. 17.15.

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
(размер стендового доклада – А0)

31 ЯНВАРЯ 16.00 – 18.45
1 ФЕВРАЛЯ 13.05 – 14.00

ФОЙЕ АУДИТОРИИ ИМ. Р.В.ХОХЛОВА

П 1 МОДЕЛЬ ЛЕГИРОВАНИЯ p-ТИПА ПРИ МОС-ГИДРИДНОЙ ЭПИТАКСИИ GaN

Е.В. Яковлев, С.Ю. Карпов, Р.А. Талалаев

П 2 ОСОБЕННОСТИ РОСТА СЛОЕВ AlGaIn МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВОЙ ЭПИТАКСИИ С ПЛАЗМЕННОЙ АКТИВАЦИЕЙ АЗОТА

А.Н. Семенов, В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, С.В. Иванов

П 3 ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КРУПНЫХ КРИСТАЛЛОВ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ

О.В. Авдеев, И.С. Бараиш, Т.Ю. Чемякова, Е.Н. Мохов, А.Д. Роенков, А.С. Сегаль, Ю.А. Водаков, Ю.Н. Макаров

П 4 КОРПУС СВЧ GaN ТРАНЗИСТОРА

В.А. Сидоров

П 5 ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ InGaIn В КВАНТОВЫХ ЯМАХ

Ермошин И.Г., Свешников Ю.Н. Харламов Р.В.

П 6 СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР AlInGaIn НА ВЫСОКИХ ПЛОТНОСТЯХ ТОКА НАКАЧКИ

Д. А. Закгейм, А.С. Павлюченко, В.В. Лундин

П 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРЬЕРА С ГРАДИЕНТОМ СОСТАВА ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ УТЕЧКИ НОСИТЕЛЕЙ ИЗ АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР

К. А. Булашев, С. Ю. Карпов, Р. А. Сурис

П 8 МЕТОД КОНТРОЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ НА ОСНОВЕ ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ AlGaInN.

Никифоров С.Г., Сушков В.П.

П 9 ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФИЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В MQW InGaIn/GaN В ПРОЦЕССЕ ДЕГРАДАЦИИ СИНИХ СВЕТОДИОДОВ

М.Г. Агапов, Е.В. Богданова, Д.В. Давыдов, А.Л. Закгейм, Д.А. Лавринович, Ф.М. Снегов, А.Е. Черняков, Н.М. Шмидт

П 10 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КВАНТОВОГО ВЫХОДА InGaIn и AlGaInP СВЕТОДИОДОВ ОТ ПЛОТНОСТИ ТОКА

А.Л. Архипов, В.С. Абрамов, В.П. Сушков, А.В. Шишов, А.Н. Туркин³

П 11 МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОТЕКАНИЯ ТОКА В КОМПЕНСИРОВАННОМ СЛОЕ СВЕТОДИОДНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ШИРОКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Ф.И. Маняхин

П 12 АНАЛИЗ ФОРМЫ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФРОНТА СПЕКТРОВ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ (ЭЛ) СВЕТОДИОДОВ С ОДИНОЧНОЙ InGaIn КВАНТОВОЙ ЯМОЙ

Д.С. Доманевский, В.А. Вилькоцкий, Ю.В. Трофимов, Б.Г. Арнаутов, Р.Д. Каканаков, С.А. Манего

П12 СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ, ЛИНЕЙКА И ЛАМПЫ БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ

Коган Л.М., Пузачев Г.В., Рассохин И.Т., Якубовский С.Д.

П 13 О МЕТОДАХ И ПРОГРАММАХ РАСЧЁТОВ ОСВЕЩЁННОСТЕЙ РАБОЧИХ МЕСТ ОТ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ

Э.М. Гутцайт

П 14 «ДВУРЕЗОНАНСНЫЙ» ГИСТЕРЕЗИС ТУННЕЛЬНОГО ТОКА В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ w -GaN/AlGaN(0001)

А.Н.Разжувалов, С.Н.Гриняев

П 15 ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ GaN, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ ХЛОРИД-ГИДРИДНОЙ ЭПИТАКСИИ, МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИМИ И РЕНТГЕНОВСКИМИ МЕТОДАМИ

Л.И.Дьяконов, Ю.П.Козлова, А.В.Марков, М.В.Меженный, В.Ф.Павлов, Т.Г.Югова

П 16 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКООМНЫХ СЛОЕВ GaN(Fe), ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВОЙ ЭПИТАКСИИ

А.Я.Поляков, Н.Б.Смирнов, А.В.Говорков, А.В.Марков, А.М.Dabiran, А.М.Wowchak, Р.Р.Chow

П 17 ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ $In_xGa_{1-x}N$

Т.А. Комиссарова, Н.Н. Матросов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов, В.Н. Жмерик, С.В. Иванов

П 18 ДИНАМИКА РЕШЕТКИ И РАМАНОВСКИЕ СПЕКТРЫ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ InGaN

А.Н. Смирнов, В.Ю. Давыдов, И.Н. Гончарук, М.А. Яговкина, Е.Е. Заварин, М.А. Синицин, М.Б. Смирнов

П 19 НАКОПЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ В МПЭ СЛОЯХ GaN ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ ЭРБИЯ

Н.А. Соболев, В.И. Сахаров, И.Т. Серенков

П 20 СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ МИГРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В КВАНТОВЫХ ЯМАХ InGaN/GaN, ЛЕГИРОВАННЫХ Eu

В.В. Криволапчук, М.М. Мездрогина, В.В. Лундин

П 21 ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ЗАХВАТА НОСИТЕЛЕЙ НА ОСОБЕННОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ В ВЬОРЦИТНЫХ КРИСТАЛЛАХ GaN, ЛЕГИРОВАННЫХ Eu, Er

М.М.Мездрогина, В.В.Криволапчук, Ю.В.Кожанова,, В.Н. Петров, С.Н. Родин, А.Е. Черенков

П 22 МОДЕЛИ ПРОВОДИМОСТИ, ЭФФЕКТА УСИЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРИДА АЛЮМИНИЯ В КАРБИДЕ КРЕМНИЯ – $(SiC)_{1-x}(AlN)_x$

Алтухов В.И., Бидалов Б.А., Казаров Б.А., Сафаралиев Г.К.

П 23 ФОМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ НАНОСТРУКТУР НОВОГО ТИПА – “НАНОСОТЫ” НА ПОВЕРХНОСТИ n-GaN(0001)

Г.В. Бенеманская, В.С. Вихнин, М.Н. Лапушкин, Н.М. Шмидт

П 24 ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 2D АККУМУЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВ Cs, Ba/n-GaN(0001) ИНТЕРФЕЙСОВ

Г.В. Бенеманская, М.Н. Лапушкин, С.Н. Тимошнев

П 25 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ СПЕКТРОВ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК InGaN

С.О. Усов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, А.В. Сахаров, Е.Е. Заварин, Е.М. Аракчеева, Н.Н. Леденцов

П 26 ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МОНОЛИТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ НА Р-НЕМТ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ ДЛЯ АФАР X-ДИАПАЗОНА.

А.Л.Кузнецов, В.Г.Мокеров, А.С.Бугаев, Ю.В.Федоров, Г.Б.Галиев, Е.Н.Енюшкина

Список участников, приславших формы предварительной регистрации

Алтухов Виктор Иванович	Пятигорский гос. технологический университет
Абрамов Владимир Семенович	ACOL Technologies S.A.
Алиев Евгений Тофикович	ACOL Technologies S.A.
Калинин Антон Алексеевич	ACOL Technologies S.A.
Линьков Александр Евгеньевич	ACOL Technologies S.A.
Рыжков Михаил Владимирович	ACOL Technologies S.A.
Столяревская Раиса Иосифовна	ACOL Technologies S.A.
Азизян Генрих Вачаганович	ACOL Technologies S.A.
Шишов Александр Валерьевич	ACOL Technologies S.A.
Сушков Валерий Петрович	МИСиС, ACOL Technologies S.A.
Ковалев Алексей Николаевич	МИСиС
Маняхин Федор Иванович	МИСиС
Архипов Александр Леонидович	МИСиС
Рабинович Олег Игоревич	МИСиС
Бадгутдинов Мансур Лябибович	МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Широков Станислав Сергеевич	МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Кашкаров Павел Константинович	МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Юнович Александр Эммануилович	МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Чукичев Михаил Васильевич	МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Боков Павел Юрьевич	МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Туркин Андрей Николаевич	МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет, ACOL Technologies S.A.
Иванников Петр Валентинович	МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Форш Павел Анатольевич	МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Ормонт Михаил Александрович	МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
Бессолов Василий Николаевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Смирнов Александр Николаевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Соболев Николай Алексеевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Семенов Алексей Николаевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Булашевич Кирилл Александрович	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Криволапчук Владимир Васильевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Мездрогина Маргарита Михайловна	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Бенеманская Галина Вадимовна	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Жмерик Валентин Николаевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Иванов Сергей Викторович	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Давыдов Валерий Юрьевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Жилиев Юрий Васильевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Родин Сергей Николаевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Николаев Андрей Евгеньевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Лундин Всеволод Владимирович	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Заварин Евгений Евгеньевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Цацульников Андрей Федорович	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Сахаров Алексей Валентинович	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Сизов Виктор Сергеевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Усов Сергей Олегович	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Копьев Петр Сергеевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Лапушкин Михаил Николаевич	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Борд Ольга	ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
Билалов Билал Аругович	ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет».
Джаббаров Расим Баба оглы	Институт Физики, НАН Азербайджана
Зайцев Алексей Константинович	ЗАО "Светлана-оптоэлектроника"
Феопёнтов Анатолий Валерьевич	ЗАО "Светлана-оптоэлектроника"
Николаев Денис Алексеевич	ЗАО "Светлана-оптоэлектроника"
Иткинсон Григорий Владимирович	ЗАО "Светлана-оптоэлектроника"
Богданов Александр Александрович	ЗАО "Светлана-оптоэлектроника"
Давыдов Денис Викторович	ЗАО "Светлана-оптоэлектроника"
Агапов Максим Г.	ЗАО "Светлана-оптоэлектроника"
Комиссарова Татьяна Александровна	МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет.
Неуважев Андрей Владимирович	ФГУП РЯЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.Н.Забахина
Разжувалов Александр Николаевич	Сибирский физико-технический институт им.Кузнецова, г.Томск
Трофимов Юрий Васильевич	Институт электроники НАН Беларуси
Цвирко Виталий Иванович	Институт электроники НАН Беларуси

Вергелес Павел Серлеевич	ИПТМ РАН, г. Черногловка
Солтанович Олег Александрович	ИПТМ РАН, г. Черногловка
Якимов Евгений Борисович	ИПТМ РАН, г. Черногловка
Савранский Валерий Васильевич	Центр естественно-научных исследований Института общей физики им.А.М.Прохорова РАН
Кудряшов Владимир Евгеньевич	МИЦ Самсунг
Курбанов Маликаждар Курбанович	Дагестанский государственный университет
Ловинский Леонид Семёнович	ФГУП «ВНИИ ОФИ»
Арендаренко Алексей Андреевич	ЗАО «Элма-Малахит», ДО ОАО «Концерн Энергомера»
Свешников Юрий Николаевич	ЗАО «Элма-Малахит», ДО ОАО «Концерн Энергомера»
Вигдорович Евгений Наумович	ЗАО «Элма-Малахит», ДО ОАО «Концерн Энергомера»
Харламов Роман Валентинович	ЗАО «Элма-Малахит», ДО ОАО «Концерн Энергомера»
Цыпленков Игорь Николаевич	ЗАО «Элма-Малахит», ДО ОАО «Концерн Энергомера»
Ермошин Иван Геннадьевич	ЗАО «Элма-Малахит», ДО ОАО «Концерн Энергомера»
Васильев Андрей Георгиевич	ФГУП НПП "Пульсар"
Крымко Михаил Миронович	ФГУП НПП "Пульсар"
Кузнецов Юрий Алексеевич	ФГУП НПП "Пульсар"
Курмачев Виктор Алексеевич	ФГУП НПП "Пульсар"
Синкевич Владимир Федорович	ФГУП НПП "Пульсар"
Филатов Анатолий Леонидович	ФГУП НПП "Пульсар"
Концевой Юлий Абрамович	ФГУП НПП "Пульсар"
Константинов Петр Борисович	ФГУП НПП "Пульсар"
Скрылев Александр Сергеевич	ФГУП НПП "Пульсар"
Корнеев Сергей Викторович	ФГУП НПП "Пульсар"
Володин Виталий Александрович	ФГУП НПП "Пульсар"
Сидоров Владимир Алексеевич	ФГУП НПП "Пульсар"
Вологдин Эрих Николаевич	ФГУП НПП "Пульсар"
Аболдуев Игорь Михайлович	ФГУП НПП "Пульсар"
Миннебаев Вадим Минхатович	ФГУП НПП "Пульсар"
Данилин Валентин Николаевич	ФГУП НПП "Пульсар"
Дорофеев Алексей Анатольевич	ФГУП НПП "Пульсар"
Гладышева Надежда Борисовна	ФГУП НПП "Пульсар"
Жукова Татьяна Александровна	ФГУП НПП "Пульсар"
Капров Дмитрий Борисович	ФГУП НПП "Пульсар"
Говорков Анатолий Васильевич	ФГУП «Гиредмет»
Поляков Александр Яковлевич	ФГУП «Гиредмет»
Смирнов Николай Борисович	ФГУП «Гиредмет»
Дьяконов Лев Иванович	ФГУП «Гиредмет»
Козлова Юлия Павловна	ФГУП «Гиредмет»
Марков Александр Владимирович	ФГУП «Гиредмет»
Меженный Михаил Валерьевич	ФГУП «Гиредмет»
Югова Татьяна Георгиевна	ФГУП «Гиредмет»
Сощин Наум Петрович	ФГУП НИИ «Платан»
Рыжиков Игорь Вениаминович	МГАПИ
Коган Лев Моисеевич	ООО «НПЦ ОЭП «ОПТЭЛ»
Рассохин Игорь Тимофеевич	ООО «НПЦ ОЭП «ОПТЭЛ»
Никифоров Сергей Григорьевич	ЗАО «АТВ - Наружные системы»
Новицкий Николай Николаевич	ИФТТиП НАН Беларуси
Стогний Александр Иванович	Минский НИИ Радиоматериалов, Беларусь
Талалаев Роман Александрович	ООО «Софт-Импакт»
Лобанова Анна Витальевна	ООО «Софт-Импакт»
Яковлев Евгений Владимирович	ООО «Софт-Импакт»
Кондратьев Алексей Викторович	ООО «Софт-Импакт»
Карпов Сергей Юрьевич	ООО «Софт-Импакт»
Рамм Марк Спиридонович	ООО «Софт-Импакт»
Сидоров Валерий Георгиевич	С-ПбГПУ (Политех)
Штурбин Анатолий Вениаминович	С-ПбГПУ (Политех)
Железняк Александр Генрихович	ООО"Магнерус", г.Троицк Московской обл.
Bondarenko Oksana	LayTec GmbH
Steimetz Elisabeth	LayTec GmbH
Гутцайт Эдуард Михайлович	МЭИ (ТУ)
Вилисов Анатолий Александрович	ОАО "НИИ полупроводниковых приборов", г.Томск
Каримбаев Дамир Джамалитдинович	ОАО "НИИ полупроводниковых приборов", г.Томск

Луценко Евгений Викторович	Институт Физики НАН Беларуси
Павловский Вячеслав Николаевич	Институт Физики НАН Беларуси
Ржеуцкий Николай Викторович	Институт Физики НАН Беларуси
Данильчик Александр Викторович	Институт Физики НАН Беларуси
Филаретов Алексей Гелиевич	ЗАО "Научное и технологическое оборудование"
Александров Сергей Борисович	ЗАО «Светлана-РОСТ»
Красовицкий Дмитрий Михайлович	ЗАО «Светлана-РОСТ»
Петров Станислав Игоревич	ЗАО «Светлана-РОСТ»
Макаров Юрий Николаевич	ООО "Нитридные кристаллы"
Чемекова Татьяна Юрьевна	ООО "Нитридные кристаллы"
Титова Ирина Георгиевна	Журнал "ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес"
Гольцова Мая Валентиновна	Журнал "ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес"
Преображенский Валерий Владимирович	Институт Физики Полупроводников СО РАН
Постолов Владимир Сергеевич	ОАО Завод синтетических корундов "Монокристалл"
Доманевский Дмитрий Сергеевич	Белорусский Национальный Технический Университет
Игнатов Александр Юрьевич	ООО НПФ "Экситон"
Вербицкий Владимир Григорьевич	НИИ Микроприборов НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины
Мазунов Денис Олегович	НИИ Микроприборов НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины
Осинский Владимир Иванович	НИИ Микроприборов НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины
Аверин Станислав Владимирович	ИРЭ РАН, г. Фрязино
Алкеев Николай Владимирович	ИРЭ РАН, г. Фрязино
Каеррелер Johannes	AIXTRON AG
Schulte Frank	AIXTRON AG
Gurary Alex	VEECO Instruments - Europe
Berry Mark	VEECO Instruments - Europe
Whitaker Tim	LEDs Magazine
Спицын Борис Владимирович	Институт физической химии РАН